

جامعة الأنبار

كلية/ التربية للعلوم الصرفة

قسم أو الفرع/ الفيزياء

المرحلة الثالثة

أستاذ المادة : م.م. هاجر حمدي نايل

اسم المادة باللغة العربية : إلكترونيك

اسم المادة باللغة الإنكليزية : **Electronics**

أسم المحاضرة الثالثة باللغة العربية: خواص الثنائي لضوئي (الدايود)

أسم المحاضرة الثالثة باللغة الانجليزية: **Diode**

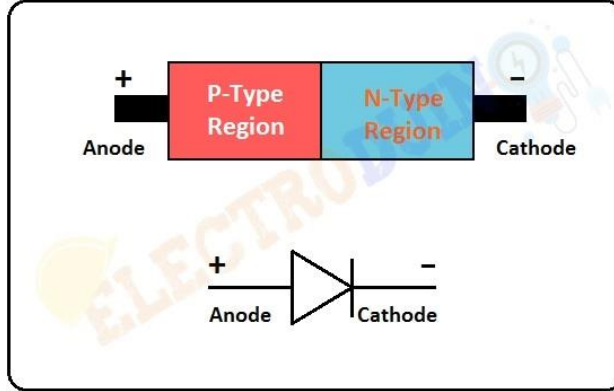
محتوى المحاضرة الثالثة

خواص الثنائي الضوئي (الدايود) Diode

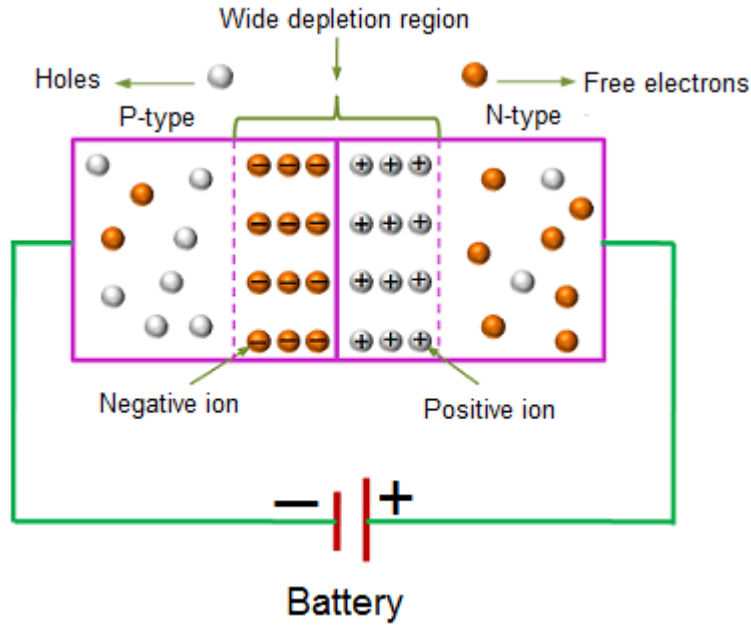
الدايود (The Diode)

يعتبر الدايود من أبسط العناصر الالكترونية والذي يستخدم للسماح للتيار الكهربائي بالمرور باتجاه معين ومنعه من المرور بالاتجاه المعاكس.

لدايود طرفان احدهما يسمى المصعد (anode) والآخر يسمى المهبط (cathode) ، ويسمح الدايود للتيار الكهربائي بالمرور من المصعد الى المهبط ويمنعه من المرور بالاتجاه المعاكس. والشكل التالي يبين رمز الدايود وطرفيه واتجاه مرور التيار الكهربائي خلاله. يتكون الدايود من اتصال بلورتين من السيليكون (أو الجرمانيوم) أحدهما موجبة والأخرى سالبة.



عند تشكيل الوصلة الثنائية (P-N Junction) يكون تركيز كل من الإلكترونات والفجوات على جانبي الوصلة بين المادتين كما هو موضح بالشكل التالي:-



ونتيجة لهذا الاختلاف في التركيز فإن بعض الإلكترونات تنتشر من الوصلة السالبة إلى الوصلة الموجبة المجاورة لها، كما تنتشر بعض الفجوات من الوصلة الموجبة إلى الوصلة السالبة، ولهذا فإن كلا الإلكترونات والفجوات في المنطقة القريبة من الوصلة تختفي وتصبح هذه المنطقة خالية من الشحنات الحرة حيث يحل مكانها أيونات موجبة في الوصلة السالبة وأيونات سالبة في الوصلة الموجبة أي إن الإلكترونات والفجوات الموجودة في منطقة الاتصال سوف تتعادل مع بعضها لتشكل منطقة خالية من الشحنات تسمى منطقة الاستنزاف (depletion region) ويعتمد عرض هذه المنطقة على نسبة تركيز الشوائب في مادة شبه الموصل، وبذلك ينشأ فرق جهد على جانبي الوصلة يطلق عليه اسم الجهد الحاجز (Barrier Voltage)، يمنع مرور الشحنات بنوعها من خلال منطقة العزل ويصل الدايمود إلى حالة الاستقرار.

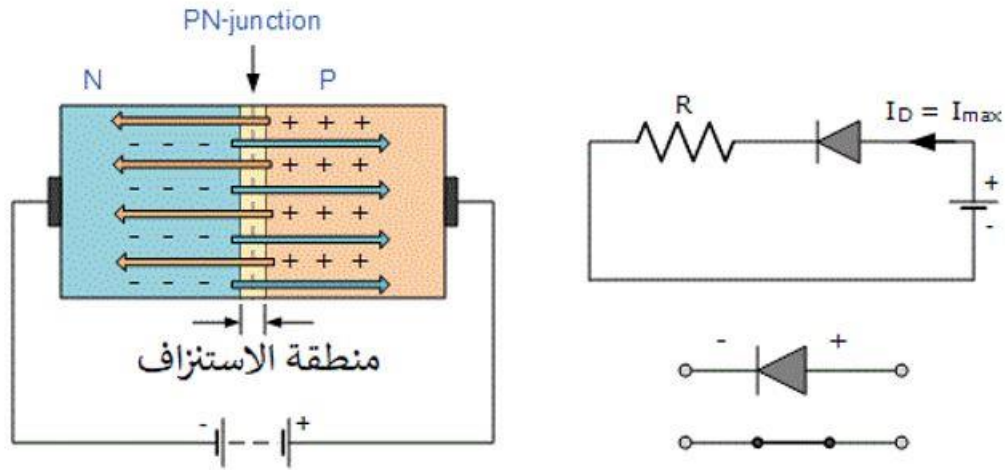
- نظراً لعدم امكانية التنقية التامة لمادة السليكون (او الجرمانيوم) والتي تصنع منها البلورتان السالبة والموجبة للدايود فسوف يكون هناك بعض الأيونات الموجبة في البلورة السالبة وكذلك بعض الأيونات السالبة أو الالكترونات الحرة في البلورة الموجبة.
- ومما يجب ذكره ان كل من الأيونات الموجبة في البلورة السالبة والالكترونات او الأيونات السالبة في البلورة الموجبة تسمى ناقلات التيار الأقلية (minority carriers) ، بينما تسمى الالكترونات في البلورة السالبة والايونات الموجبة في البلورة الموجبة ناقلات التيار الأغلبية. (majority carriers).

الدايود عند تطبيق الانحياز Diode with Applied Bias

يوجد نوعان من الانحياز هما الانحياز الأمامي (Forward Bias) والذي يكون عنده جهد المنطقة (P) موجبا بالنسبة لجهد المنطقة (N) ، والانحياز العكسي (Reverse Bias) والذي يكون عنده جهد المنطقة (N) موجبا بالنسبة لجهد المنطقة (P). وفيما يلي نستعرض كلا النوعين بشكل من التفصيل.

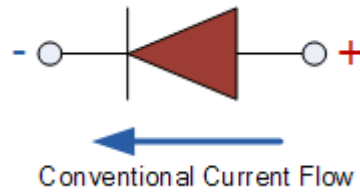
الانحياز الأمامي Forward Bias

عندما نقوم بتوصيل الديود بالبطارية بحيث يكون الجانب (p) من الدايود متصلا بالقطب الموجب من البطارية والجانب (N) متصلا بالقطب السالب، عندها الإلكترونات التي في الجزء السالب تتنافر مع القطب السالب للبطارية وتندفع لعبور الوصلة إلى الجانب (P) بينما الفجوات تتنافر مع القطب الموجب للبطارية وتندفع لعبور الوصلة إلى الجانب (N) وتصبح منطقة الاستنزاف Depletion Region بمثابة حاجزاً بسيطاً (يضيق الحاجز) في طريق حركة الإلكترونات، ولذلك فإن الإلكترونات تحتاج إلى فرق جهد بسيط يمكنها من تجاوز جهد الحاجز، ففي حالة مادة السليكون، جهد الحاجز مقداره 0,7 ، بينما قيمته 0,3 في حالة الجرمانيوم.



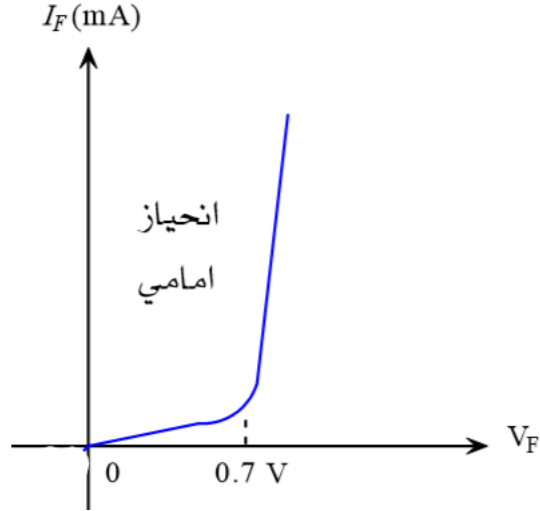
فإذا ما تم التوصيل بهذه الطريقة، فإنه يمر تيار في الوصلة يسمى في هذه الحالة بالتيار الأمامي (Forward Current I_f) ويكون اتجاهه من الوصلة الموجبة إلى الوصلة السالبة.

إن قيمة المقاومة الداخلية للدايود r_d صغيرة جدا ، وبالتالي وصل الدايود مباشرة مع المنبع سوف يؤدي لمرور تيار عال جدا فوق تحمل الدايود والذي سوف يتسبب في حرقه ولذلك تم إضافة المقاومة R على التسلسل مع الدايود لضمان عدم تجاوز التيار المار به الحد المسموح والمحدد من قبل المصنع.



رسم العلاقة بين الجهد الواقع على الدايود V_d ، والتيار المار في الدايود I_d ، فإننا نقوم بتغيير جهد المصدر V_s ، وقياس I_d و V_d فعندما يكون V_s مساوياً للصفر، فإن التيار يساوي صفراً أيضاً. وعند زيادة جهد المصدر تدريجياً، فإن التيار يبدأ بالزيادة ولكن بصورة صغيرة جداً حتى يتعدى الجهد $0.7V$ وهو الجهد اللازم لعمل الدايود. عندها يبدأ التيار بالزيادة السريعة. فكلما زاد جهد

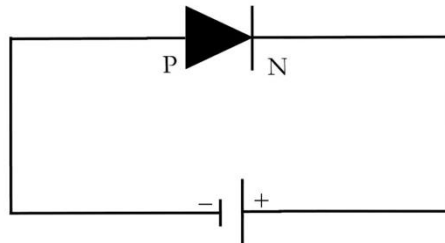
المصدر، زاد التيار وبقي جهد الدايمود ثابتا عند 0,7V تقريبا كما هو موضح في المنحني البياني التالي.



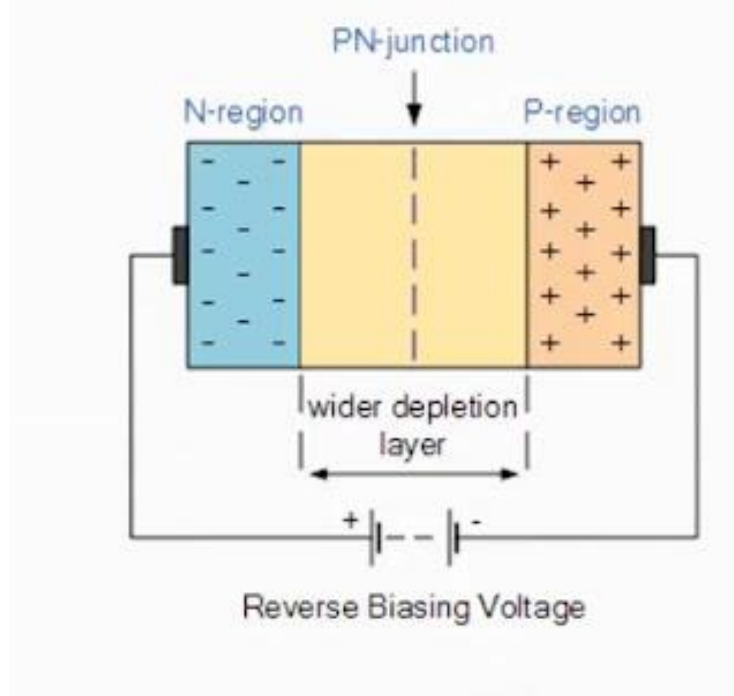
ونلاحظ من المنحني أن جهد الدايمود، V_D ، يزداد قليلا فوق 0,7V مع زيادة جهد المصدر وذلك بسبب مقاومة الدايمود الداخلية والتي تستهلك جزءا صغيرا من الجهد.

الانحياز العكسي Reverse Bias

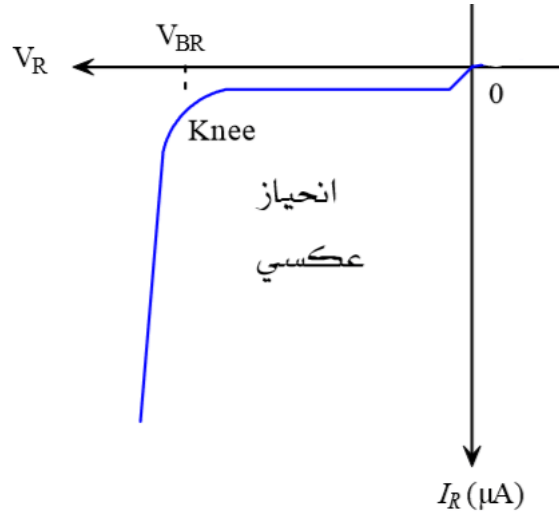
إذا تم توصيل الدايمود كما في الشكل ، بحيث يكون الجانب (N) من الدايمود متصلا بالقطب الموجب من البطارية والجانب (P) من الدايمود متصلا بالقطب السالب من البطارية، لذا فإن الإلكترونات التي في الجزء السالب تتجاذب مع القطب الموجب للبطارية وتبتعد عن الوصلة من الجانب (N). بينما الفجوات تتجاذب مع القطب السالب للبطارية وتبتعد عن الوصلة من الجانب (P). ونتيجة لذلك، فإن منطقة الاستنزاف سوف تتسع اتساعا كبيرا وتشكل حاجزا كبيرا أمام تحرك الإلكترونات فلا تستطيع اجتيازه. وبالطبع، فإنه لن يمر التيار الكهربائي في الدائرة، وتسمى هذه الحالة بالانحياز العكسي.



في هذه الحالة يمر تيار بسيط نتيجة حركة شحنات الأقلية يسمى تيار التسريب IC وسناقش لاحقا سبب ظهور هذا التيار بشكل مفصل.



ولأن في حالة الانحياز العكسي، جهد الجانب (P) أقل من جهد (N) وهنا يمر تيار صغير جدا جدا، عادة μA أو nA ويمكن اعتباره صفرا. وإذا ما استمر الزيادة في جهد المصدر، فإن الدايمود يستمر في منع التيار من المرور حتى يصل إلى حالة الانهيار Breakdown، ويسمى هذا الجهد بجهد الانهيار (Breakdown Voltage) وكما هو موضح في الشكل حيث يمر تيار عال جدا. وتختلف قيمة جهد الانهيار من دايمود لآخر حسب التصنيع.



منحنى الخواص للدايود Characteristic Curve for Diode

الشكل التالي يوضح الصورة الكاملة لعمل الدايدود، وهي أنه يعمل في حالة الانحياز الأمامي ويسمح بمرور التيار، ولكنه يحتاج إلى جهد مقداره "٠,٧"، ولا يسمح بمرور التيار في حالة الانحياز العكسي، ويجب ألا نصل إلى جهد الانهيار عند استخدامنا للدايود في حالة التطبيقات العملية. وهذا المنحنى الكامل والذي يوضح خصائص الدايدود في كلا الاتجاهين، في حالة التوصيل الأمامي والتوصيل العكسي ويسمى بمنحنى خواص الجهد والتيار للدايود.

